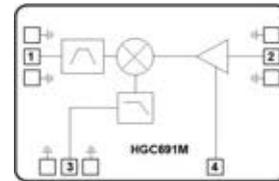
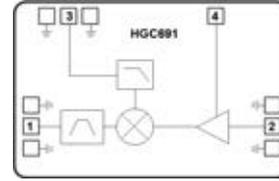




### 主要特点

- 高隔离度, 自带本振驱动
- 射频/本振频率: 20-23 GHz
- 中频带宽: DC-3 GHz
- 转换损耗: 10 dB
- LO/RF 隔离: 40 dB
- 输入 P1dB: +14 dBm
- 芯片尺寸: 2.0×1.5× 0.075 mm<sup>3</sup>

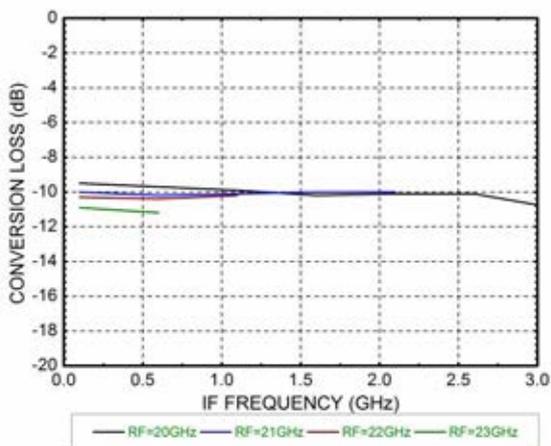
### 功能框图



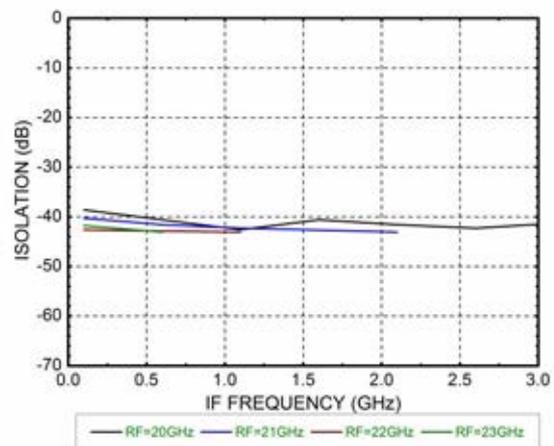
### 性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , $LO = -3\text{dBm}$ )

参数	最小	典型	最大	单位
射频频率 (RF)	20 - 23			GHz
本振频率 (LO)	20 - 23			GHz
中频频率 (IF)	DC-3			GHz
转换损耗		10		dB
隔离度 "LO 至 RF"		40		dB
隔离度 "LO 至 IF"		35		dB
隔离度 "RF 至 IF"		55		dB
输入功率 1dB 压缩点		14		dBm
输入 IP3		19		dBm

### 转换损耗

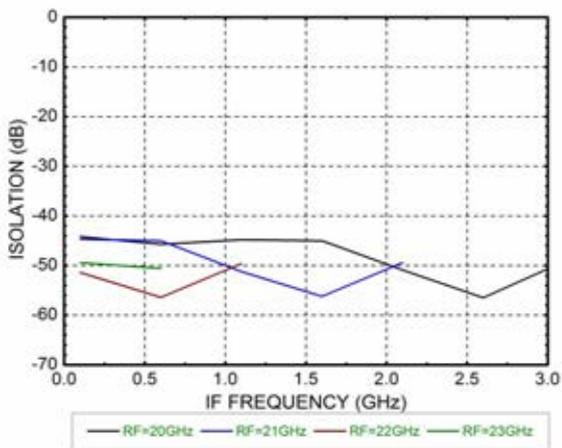


### LO-RF 隔离度

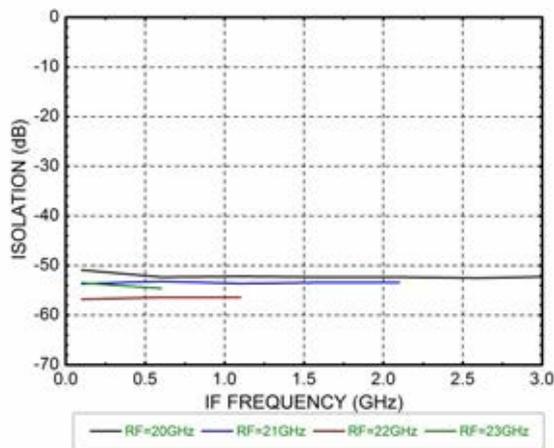




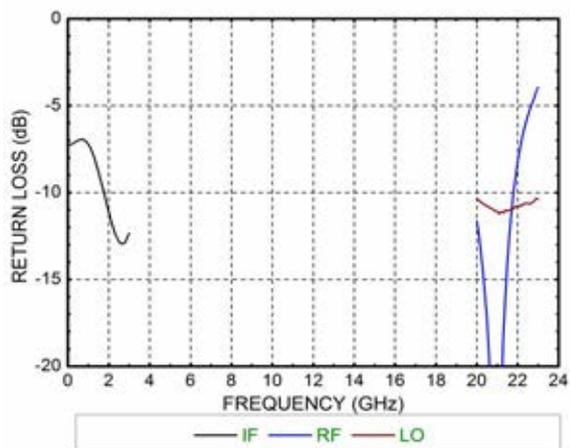
### LO-IF 隔离度



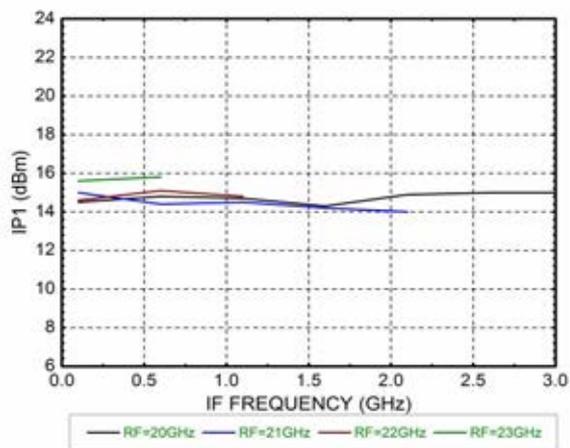
### RF-IF 隔离度



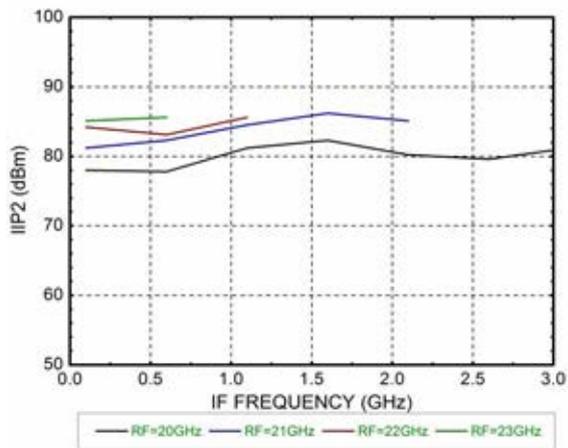
### 回波损耗



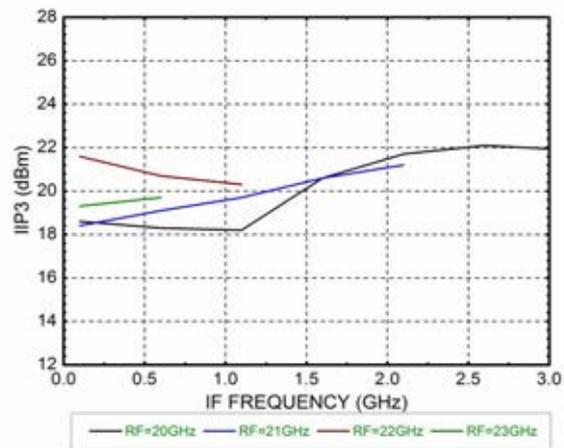
### IP1



### IIP2

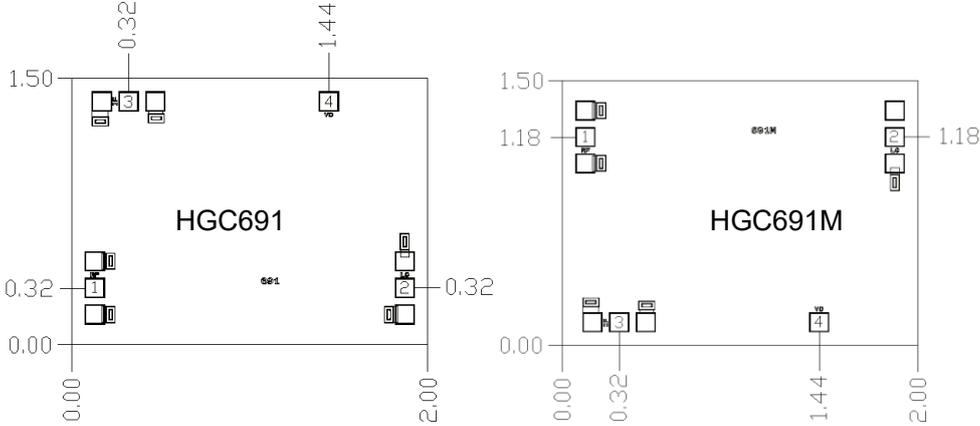


### IIP3





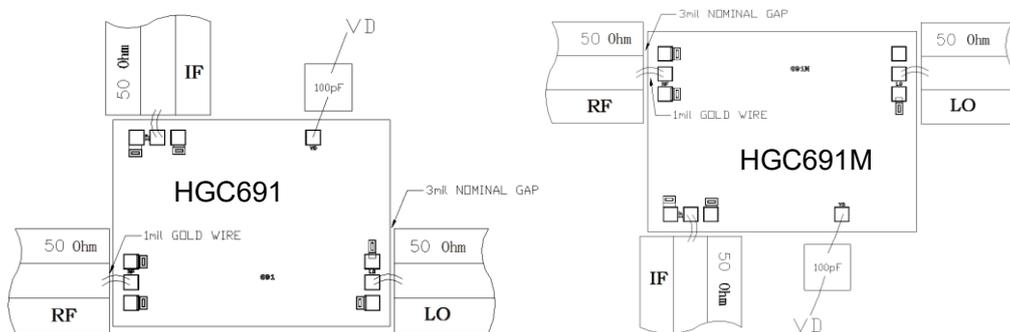
物理参数单位: 毫米



### 焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RF	该焊盘是 AC 耦合, 外部不需要接隔直电容, 并匹配至 50 Ohm
2	LO	该焊盘是 AC 耦合, 外部不需要接隔直电容, 并匹配至 50 Ohm
3	IF	该焊盘是 DC 耦合, 外部需要接隔直电容, 并匹配至 50 Ohm
4	VDD	本振放大器电源电压, +5V
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

### 装配图



### 极限参数

射频/中频输入功率: +21 dBm

储存温度: -65~+175°C

本振驱动功率: +15dBm

工作温度: -55~+85°C